

## Silicon Power Schottky Diode

$V_{RRM} = 20\text{ V} - 100\text{ V}$

$I_F = 200\text{ A}$

### Features

- High Surge Capability
- Types up to 100 V  $V_{RRM}$

Twin Tower Package



Maximum ratings, at  $T_j = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

| Parameter                                            | Symbol     | Conditions                                   | MBR20020CT (R) | MBR20030CT (R) | MBR20035CT (R) | MBR20040CT (R) | Unit |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Repetitive peak reverse voltage                      | $V_{RRM}$  |                                              | 20             | 30             | 35             | 40             | V    |
| RMS reverse voltage                                  | $V_{RMS}$  |                                              | 14             | 21             | 25             | 28             | V    |
| DC blocking voltage                                  | $V_{DC}$   |                                              | 20             | 30             | 35             | 40             | V    |
| Continuous forward current                           | $I_F$      | $T_C \leq 136\text{ °C}$                     | 200            | 200            | 200            | 200            | A    |
| Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave | $I_{F,SM}$ | $T_C = 25\text{ °C}$ , $t_p = 8.3\text{ ms}$ | 1500           | 1500           | 1500           | 1500           | A    |
| Operating temperature                                | $T_j$      |                                              | -40 to 175     | -40 to 175     | -40 to 175     | -40 to 175     | °C   |
| Storage temperature                                  | $T_{stg}$  |                                              | -40 to 175     | -40 to 175     | -40 to 175     | -40 to 175     | °C   |

Electrical characteristics, at  $T_j = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified

| Parameter             | Symbol | Conditions                                  | MBR20020CT (R) | MBR20030CT (R) | MBR20035CT (R) | MBR20040CT (R) | Unit |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Diode forward voltage | $V_F$  | $I_F = 100\text{ A}$ , $T_j = 25\text{ °C}$ | 0.65           | 0.65           | 0.65           | 0.65           | V    |
| Reverse current       | $I_R$  | $V_R = 20\text{ V}$ , $T_j = 25\text{ °C}$  | 5              | 5              | 5              | 5              | mA   |
|                       |        | $V_R = 20\text{ V}$ , $T_j = 125\text{ °C}$ | 200            | 200            | 200            | 200            |      |

### Thermal characteristics

|                                     |            |  |     |     |     |     |      |
|-------------------------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| Thermal resistance, junction - case | $R_{thJC}$ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | °C/W |
|-------------------------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|------|

Figure .1- Typical Forward Characteristics

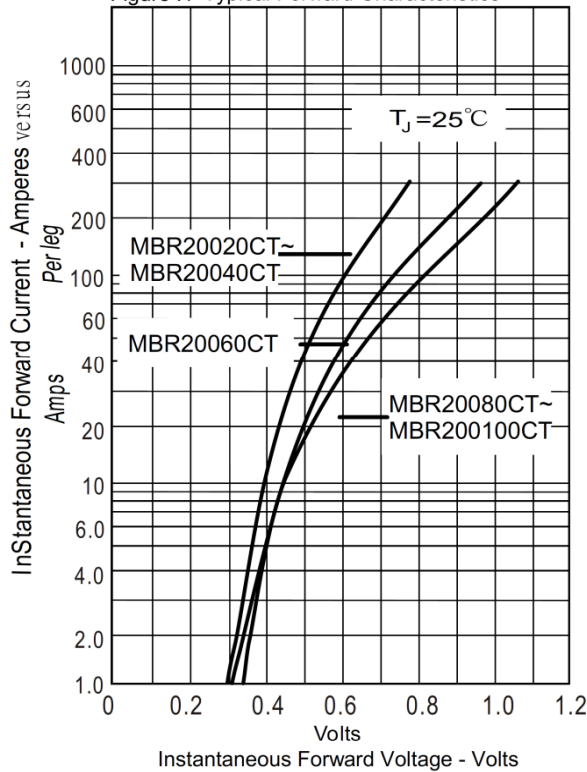


Figure .2- Forward Derating Curve

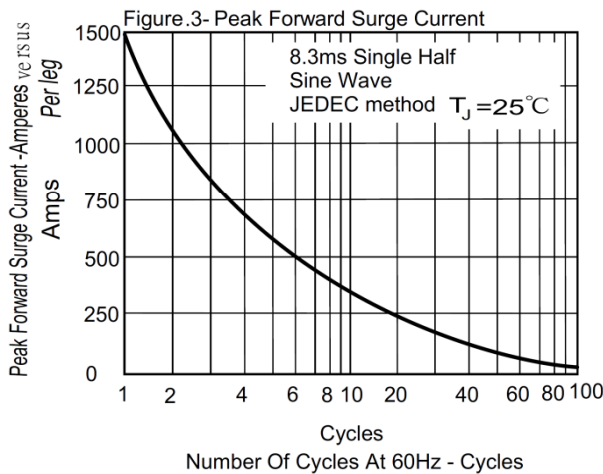
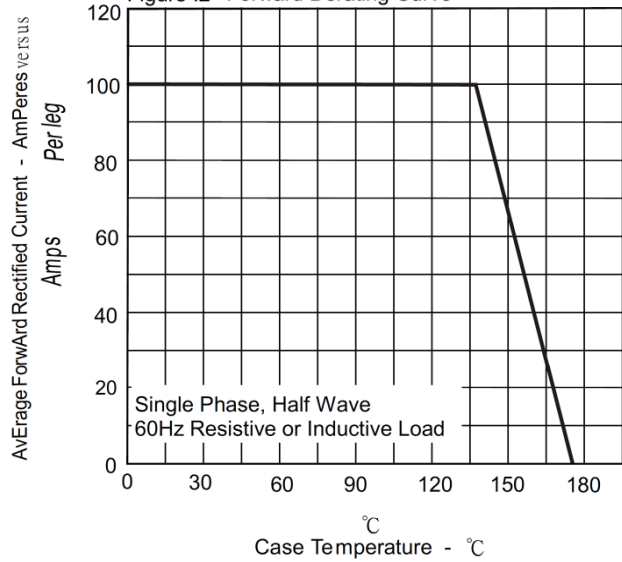
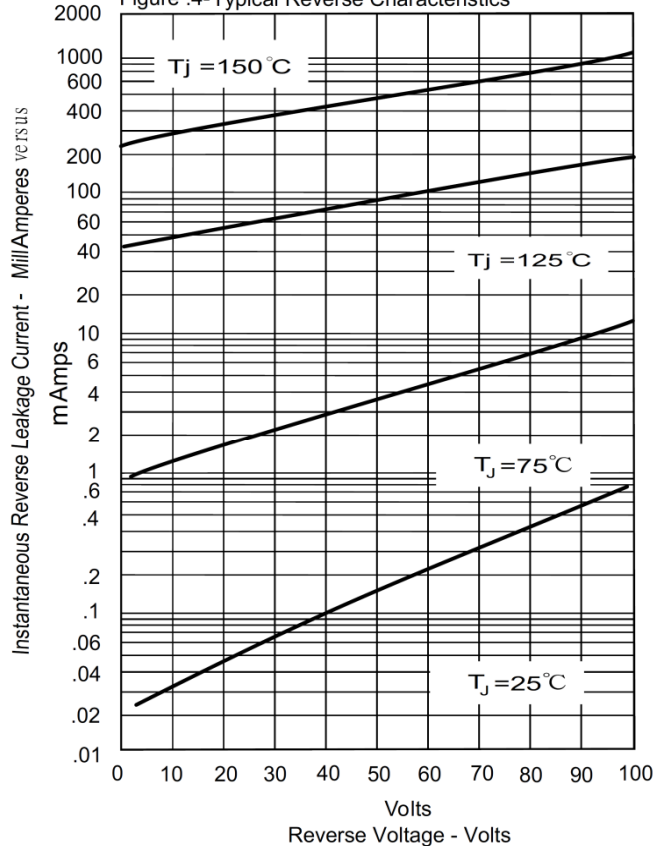


Figure .4- Typical Reverse Characteristics



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9